



(b) 2-01

圖 4-31 分別以(a) Si (100)與 (b) Si (100) /Au(10nm)為基板,相同製程 條件成長氧化鋅,成長時間為 60 分鐘之 SEM 照片



圖 4-32 分別以(a) Si (100) 與 (b) Si (100) /Au(10nm)為基板,相同製程 條件成長氧化鋅,成長時間為 120 分鐘之 SEM 照片



(c)

圖 4-33 以石英玻璃/Au(10nm)為基板成長氧化鋅奈米結構,成長時間為 60 分鐘之 SEM 照片, (a) Top view、(b) Top view tilt 30°、(c) 橫截面



圖 4-34 分別以(a) 石英玻璃與 (b) 石英玻璃/Au(10nm)為基板,相同製程條件成長氧化鋅,成長時間為 60 分鐘之 SEM 照片



圖 4-35 分別以(a) Sapphire 與 (b) Sapphire/Au 為基板,以相同製程條件成 長氧化鋅,成長時間為 60 分鐘之 SEM 照片



圖 4-36 金之(111)面與氧化鋅 c 軸之關係





圖 4-37 以化學氣相沉積法成長氧化鋅奈米柱之過程示意圖,(a) 在基板上 鍍上金膜,(b) 金膜開始凝聚,(c) 氧化鋅奈米柱在金膜上生成, (d) 隨時間增加, 奈米柱之尺寸亦逐漸增加



圖 4-38 以物理氣相傳輸法成長氧化鋅奈米帶之過程示意圖,(a) 在基板上 鍍上金膜,(b) 金膜開始凝聚,(c) 高溫處的鋅蒸汽接觸到較低溫 呈固態之金的表面時,並在金表面冷凝成液態鋅,(d) 鋅原子和環 境中的氧反應並從金與基板間能量較低之界面處開始成長氧化鋅



圖 4-39 Z.L. Wang 團隊以 VS 機制成長氧化鋅奈米帶,圖(a)與(b)為氧化 鋅奈米帶之 TEM 照片,圖(c)~(g)則為以 cation-anion molecules 來 解釋以 VS 機制成長奈米帶之示意圖[62]